CuMo 系オクタシアノ錯体における室温近傍での光誘起電荷移動現象 (東大院理¹, NEXT-JSPS², CREST-JST³) <u>梅田喜一¹</u>, 所裕子^{1,2}, 中川幸祐¹, 大越慎一^{1,3}

Photoinduced charge transfer in copper(II) octacyanomolybdate(IV) around room temperature

(Department of Chemistry, School of Science, the University of Tokyo¹; NEXT-JSPS²; CREST-JST³) <u>Yoshikazu Umeta¹</u>, Hiroko Tokoro^{1, 2}, Kosuke Nakagawa¹, Shin-ichi Okoshi^{1, 3}

【序】当研究室ではこれまでに、光や電場などの外部刺激に応答する様々なオクタシ アノ架橋型金属錯体を報告してきた¹⁻⁴。例えば、CuMo オクタシアノ錯体系では、可 視光可逆光磁性や強誘電性を示す 3 次元構造体 Cu^{II}₂[Mo^{IV}(CN)₈]・8H₂O や、低温領域 で光可逆な磁化率変化を示す 2 次元構造体 [Cu^{II}(cyclam)]₂[Mo^{IV}(CN)₈]・10H₂O (1; cyclam = 1, 4, 8, 11-tetraazacyclodecane)を報告してきた²⁻⁴。本研究では、1 における 室温近傍での光電荷移動現象を見出したので報告する。

【実験】錯体1は、K₄[Mo^{IV}(CN)₈]・10H₂O水溶液と[Cu^{II}(cyclam)]Cl₂水溶液を混合する ことにより赤紫色粉末として得た。分光測定には、フーリエ変換型赤外分光光度計 (FT-IR)を、試料の温度制御にはクライオスタットを用いた。また、照射用光源と しては半導体 CW レーザー (hv1; 410 nm, 50 mW cm⁻²)を用いた。

【結果と考察】錯体 1 の結晶構造は、 単斜晶系 ($P2_1/c$)、格子定数は a=10.2554(4)Å, b=25.239(1)Å, c=17.4581(9)Å, $\beta=99.077(2)^\circ$ であっ た。CuとMoはシアノ基で架橋され、 ca面に広がる2次元ネットワーク構造 を形成しており(図1)、CuとMoの 配位構造はそれぞれ 6 配位擬八面体 (D_{4h})とドデカヘドロン (D_{2d})であった。 図 2 に、1 の 273 K における IR スペク トルを示す。Mo^{IV}-CN-Cu^{II}のシアノ基



図1. 錯体1の結晶構造。

の伸縮振動に由来する吸収ピークが 2080 cm⁻¹ – 2140 cm⁻¹の領域で観測された。この 状態に hv1 光を3分間照射すると、図2に赤線で示すような変化が観測され、光照射 後の IR スペクトルは、30分経過すると光照射前のスペクトルに戻っていた。図3に、 光照射前と光照射直後の差分スペクトルを示す。ピーク分離により解析すると、hv1 光によって減少したピークは Mo^{IV}-CN-Cu^{II}に帰属できる一方で、光照射により発現 した A, B, C のピークはそれぞれ Mo^V-CN-Cu^{II}, Mo^V-CN-Cu^I, Mo^{IV}-CN-Cu^Iの CN 伸 縮振動に帰属できることがわかった。これらの結果より、今回室温近傍にて観測され た1の光応答性のメカニズムは、次のように考えられる。hv1 光を照射することによ

り、金属間電荷移動吸収帯が励起され Mo^{IV} から Cu^{II} への光誘起電荷移動が発現し、 $[Cu^{II}(cyclam)]_{2-r}[Cu^{I}(cyclam)]_{r}[Mo^{IV}(CN)_{8}]_{1-r}$ [Mo^V(CN)₈]_x·10H₂O(2)が生成する。時間 の経過とともに Cu^Iから Mo^Vへの逆電荷移 動が起こるため、2は1に緩和すると考え られる。なお、光照射前後の差分スペクト ルの解析結果より、xの値は0.4と見積もら れた。次に 293, 283, 263, 253 K においても 同様の光照射実験を行い、2から1へ戻る までの時間変化を調べた。その結果、温度 が低くなるに従い、2が1へ戻るまでの時 間は長くなり、例えば 293 K では 2 分であ ったが、253 K では660分であった(図4)。 そこで次に、協同効果が働く系の緩和式(1)5 を用いてこれらの結果を解析した。

$$\frac{\mathrm{d}\gamma_2}{\mathrm{d}t} = \alpha \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{a}} + E_{\mathrm{a}}^* \gamma_2}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\gamma_2 \tag{1}$$

(h_2 は2の割合、 E_a は2から1への逆電荷 移動の活性化エネルギー、 E_a^* は協同効果に 基づく活性化エネルギー、 α は比例定数、 k_B はボルツマン定数を表す)その結果、本 系の活性化エネルギーの値は、 $E_a = 9100$ cm⁻¹、 $E_a^* = 115$ cm⁻¹と見積もられた。 E_a^* の値は、スピンクロスオーバー錯体で報告 されている値と同程度であったが、 E_a の値 は、スピンクロスオーバー錯体等と比較し て 10 倍程度大きな値であった。したがって、 本系では E_a の値が大きいために、室温近傍 における光誘起電荷移動現象を観測できた と考えられる。



図 3. 273 K における 1 の光照射前後の IR 差分スペクトル(赤線)とピーク分離。赤 点線は hv1 光により減少したピーク、青線 は光生成したピーク、黒点線は A-D の足し 合わせを表す。



- [1] H. Tokoro, S. Ohkoshi, *Dalton Trans.*, 40, 6825 (2011).
- [2] S. Ohkoshi, H. Tokoro, T. Hozumi, Y. Zhang, K. Hashimoto, C. Mathonière, I. Bord, G. Rombaut, M. Verelst, C. C. D. Moulin, F. Villain, *J. Am. Chem. Soc.*, 128, 270 (2006).
- [3] K. Nakagawa, H. Tokoro, S. Ohkoshi, Inorg. Chem., 47, 10810 (2008).
- [4] H. Tokoro, K. Nakagawa, K. Nakabayashi, T. Kashiwagi, K. Hashimoto, S. Ohkoshi, *Chem. Lett.*, 38, 338 (2009).